CLIPPEDIMAGE= JP359033430A

PAT-NO: JP359033430A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59033430 A

TITLE: OPTICAL SWITCH

PUBN-DATE: February 23, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAMASHITA, MAKI INOUE, NAOHISA MORI, KAZUHIKO MATANO, MASAHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

OMRON TATEISI ELECTRONICS CO

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP57144053

APPL-DATE: August 19, 1982

INT-CL (IPC): G02F001/31; G02B005/174

US-CL-CURRENT: 427/301

ABSTRACT:

PURPOSE: To attain a high extinction ratio, by providing heating electrodes independent of each other near the base part side and the branch part side of a branching optical waveguide formed with an optical material whose refractive index is changed by temperature.

CONSTITUTION: A Y-shaped optical waveguide 2 is formed on a soda glass

substrate 1, and this optical waveguide 2 is constituted with a base part $\ensuremath{\text{3}}$ and

two branch parts 4 and 5 branched from the base part 3 at equal angles.

Rhombic heating electrodes 6, 7, and 8 are formed near one another on the side

of the base part 3 and the side of branch parts 4 and 5 in the branching $\,$

position of the Y-shaped optical waveguide 2. Heating electrodes 6∼8 are

formed by vapor-depositing Ni-Cr, Ti or the like and are independent of one another, and electrical conduction is controlled individually by a power supply circuit 9.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-33430

⊕Int. Cl.3

G 02 F 1/31

G 02 B 5/174

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和59年(1984)2月23日

7348—2H 8106—2H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

分光スイツチ

願 昭57-144053

②出

@特

願 昭57(1982)8月19日

@発 明 者

者 山下牧

者 山下牧

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

⑩発 明 者 井上直久

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

切発 明 者 森和彦

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

⑩発 明 者 俣野正治

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

⑪出 願 人 立石電機株式会社

京都市右京区花園土堂町10番地

砂代 理 人 弁理士 岸本瑛之助 外4名

明 和 書(3)

1. 発明の名称

光スイツチ

2. 特許請求の範囲

この光導波路の分岐場所上において、基幹部 側および分岐部側にそれぞれ独立にかつ近接し て設けられた発熱電極、

を備えた光スイツチ。

3. 発明の詳細な説明

この発明は光スイッチに関し、特に温度によって 屈折率が変化する熱光学効果を利用した光スイッチに関する。

現在、光導波路の材料としては穏々のものが

提案され、使用されている。ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウムなどによつて代表される強 誘電体材料、ガリウムヒ素が代表的な化合物半 導体、バイコール、バイレツクス、BK7など が代表的なガラス材料、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリスチレン(PS)など の高分子材料、Y1Gが代表的な物質である磁 性材料などがあげられる。

そして強誘電体材料で形成された光導波路においては電気光学効果や音響光学効果を利用して光スイッチが実現されている。化合物半導体では、主にPn接合の空乏層の厚さを変えることで光導波路の厚さを変え、モードのカットオフ状態と導波状態とを切り替えている。化合物半導体においては、さらに音響光学効果を用いても光のスイッチングは可能である。磁性材料でも

特開昭59-33430(2)

は磁気光学効果により光のスイッチングが行われている。

ガラス材料および高分子材料はいずれも、電 気光学効果、磁気光学効果、音響光学効果等を もたないために光導波路の屈折率の制御に難点 があり、光スイツチの実現は困難であった。強 誘電体材料や化合物半導体においては数μm 程 度の膜厚の光導波路しか作製できないのに対し、 ガラス材料および高分子材料では数10μm 以 上の厚膜の光導波路が作製できるという長所が あるので、これらの材料においても光スイツチ の実現が狙まれていた。

ガラス材料および高分子材料の屈折率制御を 行なう唯一の方法は、温度により屈折率が変化 する熱光学効果を利用することである。 しかし 現在までに熱光学効果を利用したカットオフ型

は最適ではなく、放射光が他の光導波路を伝搬する光のノイズとなる可能性があるなどの欠点がある。

この発明は上述の実情に鑑み、熱光学効果を利用した光スイッチであって、厚膜光導波路が作製可能なガラス材料や高分子材料にも適用することができ、しかも構造が簡単で、高消光比を得ることができ、高集積化が可能な構造の光スイッチを提供することを目的とする。

この発明による光スイッチは、温度により屈 折率の変化する光学材料によって形成され、基 幹部およびこれより分岐する2つの分岐部から なる光導波路ならびにこの光帯波路の分岐場所 上において、基幹部側および分岐部側にそれぞ れ独立にかつ近接して設けられた発熱電極、を 備えていることを特徴とする。

の光スイッチが提案されているだけである。こ の光スイッチにおいては3次元光導波路の一定 長部分が低屈折率になつており光導波路がこの 部分で切れた状態となつている。この低屈折率 部分上には発熱電極が作製されており、その発 熱により屈折率が高くなり光導波路がつながる ことにより光導波路中の光が伝搬する。発熱電 極による発熱がない場合には、低屈折率部分で 光導波路のモードはカットオフとなり光は基板 方向に放射され、光導波路を伝搬する光量が減 少するので、発熱電極の発熱の有無により光ス イッチングが可能となる。しかしながら、この 構造の光スイツチでは、発熱電極を発熱させな い場合には、光が基板方向に放射され光が有効 に利用されないという問題がある。また高集務 化した場合などにはカツトオフ構造のスイツチ

以下、図面を参照してこの発明の実施例について群途する。

特開昭59-33430(3)

第1図において、代表的なガラス材料であるソーダガラス基板(1)上にY字形の光導波路(2)が形成されている。光導波路(2)は、基幹部(3)と、
これより等角度で分岐する2つの分岐部(4)(5)とから構成されている。光導波路(2)はたとえば銀の拡散により作製される。すなわち、基板(1)表面に、光導波路(2)となる部分を除が着し、基準を形成する。この後、光導波路(2)となるが分を、光導波路(2)となる部分を除着した。ない、光線波路(2)となるの後、光導波路(2)となるの後、光波波路(2)となる部分にのみ拡散される。銀は光導波路(2)となる部分にのみ拡散される。銀は光導波路(2)となる部分にのみ拡散される。

d - ...

このようなY字形光導波路(2)の分岐場所上において、基幹部(3)側および分岐部(4)(5)側にそれでれ、互いに近接して菱形の発熱電極(6)および

を伝搬してきた光は、第3図に示すように高屈 折事部分の光導波路中のみを伝搬し分岐部(4)の みに進む。分岐部(5)の屈折率は発熱電極(6)(7)直 下の部分の屈折率よりも低く、光はこの分岐部 (5)へは漏れない。発熱電極(6)(8)を電源回路(9)に よつて発熱させると、電極(6)(8)直下の光波路 の屈折率が増加し、光は分岐部(5)へ伝搬する。 そして、分岐部(4)へは光は漏れない。このよう に、発熱させるべき発熱電極を切り替えること により、分岐部(4)または(5)への光のスイッチン が遊成される。

この発明には、熱光学効果をもつすべての材料に適用可能であり、ガラス材料、高分子材料 に限定されないのは言うまでもない。 甚板上に 光導波路を形成するための不純物の種類も茘板 の材料に応じて選択されるべきのものであり、 (7) (8) が形成されている。発熱電極(6) ~ (8) はたとえば N i ー C r、 T i などを蒸着することにより形成される。 これらの発熱電極(6) ~ (8) は相互に独立であり、 電源回路(9) によって別個に通電制のこれる。発熱電極への印加電圧は交流であってもよい。発熱電極への通路であってもよい。発熱電極への通路であってもよい。発熱電極への通路であってもよい。発熱電極が発熱すると、その直下の光波は、 2 分発熱電極が発熱すると、その直下の光波は、 2 分発熱電極が発熱すると、その直下の光波では、 2 分発熱電極が発熱すると、 その直下の光波では、 2 分析ラスの場合、 0 ~ 1 0 0 ℃の温度範囲で最大 1 0 −3 程度の周折率変化が生じる。

発無電極(6)~(8)のいずれもが発熱していない 場合には、甚幹部(3)を伝搬してきた光は第2図 に示すように両分骸部(4)(5)に等しく分れて進む。 これらの発熱電極中の2つの発熱電極(6)(7)を電 源回路(9)によつて発熱させると、電極(6)(7)下の 光導波路の屈折率が増加するこのため芸幹部(3)

また発熱電板の形状およびその材料も任意に決定することができる。

4. 図面の簡単な説明

邦 1 図はこの発明の実施例を示す斜視図、第 2 図および第 3 図は光のスイッチングの様子を 示す図である。

(1) ••• 菇板、(2) ••• Y 字形光導波路、(3) ••• 菇幹部、(4) (5) ••• 分岐部、(6) (7) (8) ••• 発熱電極。

以上

特許出願人 立石電機 株式会社代理人 岸本 瑛 之 的 未通





